

Matematicko-fyzikálny časopis

Július Krempaský

Koncentrácia voľných nosičov náboja v nehomogénnom polovodiči s jedným typom vodivosti

Matematicko-fyzikálny časopis, Vol. 9 (1959), No. 1, 19--28

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/126932>

Terms of use:

© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1959

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

KONCENTRÁCIA VOENÝCH NOSIČOV NÁBOJA V NEHOMOGÉNNOM POLOVODIČI S JEDNÝM TYPOM VODIVOSTI

JÚLIUS KREMPASIS, Bratislava

Úvod

Teoretickí fyzici v svojich prácach spravidla vždy požadujú prísmé homogénne vzorky polovodičov, hoci pri bežných spôsoboch výroby možno týto požiadavku len veľmi ľahko splniť. Polovodičové vzorky typu n alebo typu p pripravené fahaním monekryštálu z taveniny alebo zónovou tavbou bývajú znečistené tak, že v ich vnútri existuje spojity gradient koncentrácie atómov nečistoty (alebo prímesí).

Gradient koncentrácie nečistoty (alebo prímesí) zapríčinuje, že vo vzorke vznikne aj gradient iných fyzikálnych veličín, ktorými polovodič charakterizujeme; napr. vodivosti, odporu atď. Samozrejme, že gradient týchto veličín závisí od gradiента nečistoty, no jeho priebeh všeobecne je od neho odlišný, pretože sa na vytvoreni ustáleného stavu vo vzorke značnou mierou podieľa difúzia elektrónov a dier z miest o väčšej koncentrácií do miest s menšou koncentráciou. V ustálenom stave je vzorka polovodiča charakterizovaná koncentráciou elektrónov a dier, ktoré nezodpovedajú koncentráciám atómov nečistoty v teplej rovnováhe v homogénnej vzorke, pretože tepelne rovnovážny stav porušila difúzia. Tieto nové ustálené koncentrácie nazývame nerovnovážne koncentrácie¹⁾ a práve ony určujú gradienty všetkých ostatných charakteristických veličín polovodiča. Poznať tieto nerovnovážne koncentrácie je preto základným problémom.

Z iného hľadiska je výpočet nerovnovážnych koncentrácií dôležitý napr. vo vzorkách vedome nehomogénne znečistených za účelom, aby sa v nich realizovali rôzne efekty, napr. usmerňovací alebo fotovoltaický efekt, ktorý študoval Tauc [1]. Teoretický rozbor týchto efektov predpokladá znalosť týchto ustálených hodnôt koncentrácií nositeľov náboja.

¹⁾ Názvami „rovnovážna“ a „nerovnovážna“ koncentrácia označujeme koncentráciu pred, resp. po difúzii, preto vo všeobecnosti nemajú taký význam ako v termodynamike.

1. Formulácia problému

V tejto práci sa budeme zaoberať len prípadom polovodiča s jedným typom vodivosti. Budeme teda predpokladať takú koncentráciu donorových, resp. akceptorových hladín, aby vlastná vodivosť materiálu bola oproti prímesnej vodivosti zanedbateľne malá. Výsledky budeme preto môcť aplikovať hlavne na polovodiče so širším zakázaným pásmom. Avšak aj v germániu pri izbových teplotách pri koncentráции atómov nečistoty $N = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ je už vlastná vodivosť tisíckrát a v kremíku dokonca 10^9 -krát menšia ako prímesná vodivosť.

Nech naša vzorka je napr. typu n (pre vzorky typu p boli by úvahy úplne analogické) a nech je nehomogénne znečistená v smere osi X . Podľa [2] a [3] sa koncentrácia atómov prímesí v bežne zónovou stavbou pripravených vzorkách dá v podstate vyjadriť vzťahom

$$N(x) = N_0 e^{ax},$$

kde exponent a je podiel tzv. segregácej konštanty a dĺžky zóny. Podľa údajov [4] a [5] majú segregáčné konštanty nečistôt v germániu a v kremíku hodnoty okolo jednotky a menšie, takže budeme môcť požadovať, aby odchýlky od rovnovážnej koncentrácie neprevýšili samotné rovnovážne koncentrácie nositeľov náboja. Dokážeme si však, že tento predpoklad je splniteľný i pri oveľa väčších nehomogenitách.

Hraničné podmienky na styku polovodiča s iným prostredím sú neobyčajne zložité [6]. Aby sa zložitosťou matematického výpočtu s rešpektovaním týchto podmienok nezmenenila jednoduchá interpretácia výsledkov, budeme predpokladať, že naša vzorka je nehomogénna len v intervale $[0, l]$ a naľavo i napravo od tejto oblasti má koncentrácia prímesí konštantnú hodnotu. Znečistenie nech je teda určené týmito vzťahmi:

$$\begin{array}{ll} x = -\infty, 0 & N(x) = N_0, \\ x \in [0, l] & N(x) = N_0 e^{ax}, \\ x = l, +\infty & N(x) = N_0 e^{al} = N(l). \end{array} \quad (1.1)$$

Pretože aktivačná energia elektrónov na donorových hladinách mälokedy presahuje niekoľko stotín eV, sú za normálnych teplôt tak v germániu, ako aj v kremíku všetky donorové hladiny ionizované. Keby nebolo difúzie, bola by v každom bode vzorky koncentrácia voľných elektrónov určená funkciami (1.1). Voľné elektróny difundujú však zo znečistenejšej oblasti do oblasti s menšou koncentráciou nečistoty zanechávajúc po sebe kladný náboj iónov. Vo vzorke tečie preto prúd o hustote (pozri napr. [8])

$$i = enu \mathbf{E} + nkT \operatorname{grad} n, \quad (1.2)$$

kde n je koncentrácia voľných elektrónov,

u je pohyblivosť elektrónov.

e je náboj elektrónu,

\mathbf{E} je intenzita elektrostatického pola vo vzorke,

k je Boltzmanova konštantá,

T je absolútна teplota Kelvinova.

Stacionárny stav bez vonkajšieho napäťa, t. j. pri nulovom prúde vo vzorke je zrejme charakterizovaný podmienkami

$$i = \mathbf{0}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} = \frac{e}{\varepsilon} (n_0 - n), \quad (1,3)$$

kde ρ je priestorový náboj, n_0 je koncentrácia ionizovaných donorových hladín a ε dielektrická konštantá prostredia.

Ak predpokladáme jednorozmerný problém (v reze y, z je vzorka homogénna), dostaneme na základe (1,2) a (1,3) pre nerovnovážnu koncentráciu elektrónov túto diferenciálnu rovnici:

$$\frac{d^2}{dx^2} \ln n + \frac{e^2}{ekT} (n_0 - n) = 0. \quad (1,4)$$

Jej riešenie budeme hľadať v tvare

$$n = n_0 z. \quad (1,5)$$

Za predpokladu, že odchýlky od rovnovážnej koncentrácie nebudú presahovať samotné rovnovážne koncentrácie, môžeme pre z písť

$$z = e^y = 1 + y. \quad (1,6)$$

Na základe (1,4), (1,5) a (1,6) pri uvážení, že $\frac{d^2}{dx^2} \ln n_0 = 0$, dostaneme pre y nasledujúcu diferenciálnu rovnici:

$$\frac{d^2y}{dx^2} - c^2 N_0 e^{ax} y = 0; \quad c = \sqrt{\frac{e^2}{ekT}}. \quad (1,7)$$

2. Hraničné podmienky a riešenie rovnice (1,7)

Rovnicu (1,7) budeme riešiť v troch oblastiach vyznačených funkciami (1,1). Pri riešení vystúpi preto 6 neurčitých konštánt, pre ktoré potrebujeme 6 podmienok. Predovšetkým budeme požadovať splnenie prirodzených podmienok v nekonečnu, t. j.

$$\text{pre } x \rightarrow -\infty \quad n_1 = n_1^0; \quad y_1 = 0, \quad (2,1a)$$

$$\text{pre } x \rightarrow +\infty \quad n_{111} = n_{111}^0; \quad y_{111} = 0. \quad (2,1b)$$

Na rozhraní II. a III. oblasti budeme predpokladať spojitosť koncentrácie nosičov náboja a spojitosť prúdu, čo vyplýva z rov. $\text{div } \mathbf{i} = 0$. Na základe (1,2), (2,1) a (1,1) môžeme ostatné podmienky formulovať takto:

$$\text{pre } x = 0 \quad y_1 = y_{11}, \quad (2.2a)$$

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{dy_{11}}{dx} + a(1 + y_{11}), \quad (2.3a)$$

$$\text{pre } x = l \quad y_{11} = y_{111}, \quad (2.2b)$$

$$\frac{dy_{111}}{dx} = e^{al} \left[\frac{dy_{11}}{dx} + a(1 + y_{11}) \right]. \quad (2.3b)$$

V oblasti I a III je $n_0 = N_0$, resp. $n_0 = N_l$, preto riešenie rov. (1,7) je

$$y_1 = C_1 \cosh(c \sqrt{N_0} x) + C_2 \sinh(c \sqrt{N_0} x), \quad (2.4a)$$

$$y_{111} = C_5 \cosh(c \sqrt{N_l} x) + C_6 \sinh(c \sqrt{N_l} x). \quad (2.4b)$$

S ohľadom na podmienky (2,1a) a (2,1b) je však $C_2 = C_6 = 0$. V II. oblasti, kde $n_0 = N_0 e^{ax}$, môžeme riešenie rovnice (1,7) vyjadriť takto:

$$y_{11} = C_3^* J_0 \left(\frac{2i c}{a} \sqrt{N_0} e^{\frac{ax}{2}} \right) + C_4^* H_0^{(1)} \left(\frac{2i c}{a} \sqrt{N_0} e^{\frac{ax}{2}} \right) \quad (2.5)$$

J_0 je Besselova funkcia nultého rádu a $H_0^{(1)}$ Hankelova funkcia multého rádu prvého druhu (pozri napr. [7]).

C_3^* a C_4^* sú všeobecne komplexné čísla. Keďže pre Besselove funkcie platí

$$J_r(i\eta) = \bar{J}_r(\eta) \cdot i^r;$$

kde

$$\bar{J}_r(\eta) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(k+1) \Gamma(k+r+1)} \cdot \left(\frac{\eta}{2} \right)^{r+2k},$$

a pre Hankelove funkcie

$$\frac{\pi}{2} i H_0^{(1)}(i\eta) = - \left(\ln \frac{\eta}{2} + 0,577215 \right) \bar{J}_0(\eta) + \left(\frac{\eta}{2} \right)^2 + \dots = K_0(\eta),$$

môžeme reálne riešenie rovnice (1,7) dostať vtedy, ak položíme $C_3^* = C_3$

a $C_4^* = \frac{\pi}{2} i C_4$. Môžeme ho napísaať v tvare

$$y_{11} = C_3 \bar{J}_0 \left(\frac{2c}{a} \sqrt{N_0} e^{ax} \right) + C_4 K_0 \left(\frac{2c}{a} \sqrt{N_0} e^{ax} \right). \quad (2.6)$$

Riešenie hraničných podmienok s ohľadom na riešenia (2,4) a (2,6) viedie k málo prehľadným a pre interpretáciu nevhodným vzorecom. Všimneme si len približné riešenie, ktoré však bude dobre vystihovať takmer všetky prípady, vyskytujúce sa v praxi.

Pre germánium napr. je

$$c = \sqrt{\frac{e^2}{\varepsilon k T}} \approx 2 \cdot 10^{-4} \quad [AKMS]$$

Z tejto hodnoty vyplýva, že pokial koncentrácia nečistoty presahuje hodnotu 10^{10} cm^{-3} (a to je vždy, pretože celkom čisté materiály sa dodnes ešte nepodarilo vyrobiť), je vždy splnená nerovnosť

$$\frac{2c}{a} \sqrt{N_0} e^{\frac{ax}{2}} \gg 1. \quad (2,7)$$

Táto nerovnosť však značí, že argumenty Besselových funkcií sú veľmi veľké a že teda možno pre ne používať tieto asymptotické vyjadrenia:

$$\lim_{\eta \rightarrow \infty} J_v(\eta) = \sqrt{\frac{1}{2\pi\eta}} e^\eta, \quad (2,8)$$

$$\lim_{\eta \rightarrow \infty} K_v(\eta) = \sqrt{\frac{\pi}{2\eta}} e^{-\eta}. \quad (2,9)$$

Na základe nerovnosti môžeme aj hyperbolické funkcie (2,4a) a (2,4b) approximovať vzorcami platnými pre veľké argumenty, t. j.

$$\lim_{\eta \rightarrow \infty} \cosh \eta = \frac{1}{2} e^\eta,$$

$$\lim_{\eta \rightarrow \infty} \sinh \eta = \frac{1}{2} e^\eta.$$

Ak si konečne zavedieme označenia

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \sqrt{\frac{a}{4\pi c \sqrt{N_0}}} \frac{a}{4} e^{\frac{2c}{a} \sqrt{N_0}}, \\ \beta_t &= \sqrt{\frac{a}{4\pi c \sqrt{N_0}}} e^{\frac{2c}{a} \sqrt{N_0} e^{\frac{al}{2}}} \cdot c \left[\sqrt{N_0} e^{\frac{al}{4}} + \sqrt{N_t} e^{-\frac{al}{4}} \right], \\ \gamma_0 &= \sqrt{\frac{a\pi}{4c \sqrt{N_0}}} e^{-\frac{2c}{a} \sqrt{N_0}} \cdot \left[2c \sqrt{N_0} - \frac{a}{4} \right], \\ \gamma_t &= \sqrt{\frac{a\pi}{4c \sqrt{N_0}}} e^{-\frac{2c}{a} \sqrt{N_0}} \left[c \sqrt{N_t} e^{-\frac{al}{4}} - c \sqrt{N_0} e^{\frac{al}{4}} - \frac{a}{4} e^{\frac{al}{4}} \right], \end{aligned} \quad (2,12)$$

môžeme neznáme konštanty C_1 , C_3 , C_4 a C_6 vyjadriť vzorcami

$$\begin{aligned} C_1 &= a \frac{K_0(0)(\beta_l + \beta_0 e^{al}) - J_0(0)(\gamma_l + \gamma_0 e^{al})}{\gamma_0 \beta_l - \beta_0 \gamma_l} \\ C_3 &= -a \frac{\gamma_l + \gamma_0 e^{al}}{\gamma_0 \beta_l - \beta_0 \gamma_l} \\ C_4 &= a \frac{\beta_l + \beta_0 e^{al}}{\gamma_0 \beta_l - \beta_0 \gamma_l} \\ C_6 &= a e^{c_0 \sqrt{N_0} l} \left[\frac{K_0(l)(\beta_l + \beta_0 e^{al}) - J_0(l)(\gamma_l + \gamma_0 e^{al})}{\gamma_0 \beta_l - \beta_0 \gamma_l} \right] \end{aligned} \quad (2.13)$$

Symboly $K_0(0)$, $J_0(0)$, resp. $K_0(l)$, $J_0(l)$ sú hodnoty funkcií

$$\begin{aligned} &\left| K_0 \left(\frac{2c}{a} \sqrt{N_0} e^{\frac{ax}{2}} \right) \right|_{x=0}, \quad \left| J_0 \left(\frac{2C}{a} \sqrt{N_0} e^{\frac{ax}{2}} \right) \right|_{x=0}, \\ \text{resp. } &\left| K_0 \left(\frac{2C}{a} \sqrt{N_0} e^{\frac{ax}{2}} \right) \right|_{x=l}, \quad \left| J_0 \left(\frac{2C}{a} \sqrt{N_0} e^{\frac{ax}{2}} \right) \right|_{x=l}. \end{aligned}$$

Konštanta C_1 , ako ihneď vyplýva z (2.4a), určuje podiel zmeny koncentrácie a pôvodnej koncentrácie v bode $x = 0$, t. j.

$$C_1 = \frac{n_1 - n_0}{n_0}.$$

Na základe vzťahov (2.12) a (2.13) vychádza pre ňu približná hodnota

$$\frac{n - n_0}{n_0} \approx \frac{a}{\sqrt{\frac{e^2 N_0}{ekT} + a}}, \quad (2.14)$$

čo pri $N_0 = 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ dáva asi $a/1000$ a pri $N_0 = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ už len $a/10\ 000$. Pri bežných znečisteniach v typických polovodičoch (germánium a kremík) je podľa toho difúzia nosičov náboja vo vzorke s jediným typom vodivosti zanedbateľne malá.

Pri podstatne väčších nehomogenitách (v bariérah) a pri koncentráciách $N_0 = 10^{10} - 10^{11} \text{ cm}^{-3}$ môže sa však hodnota $c \sqrt{N_0}$ priblížiť naofko k a , že by odchýlky narastli aj nad samotné rovnovážne koncentrácie.

Veľmi zaujímavý prípad by nastal, keby sa podarilo vytvoriť nehomogenitu akceptorových, resp. donorových hladín v polovodičoch s vysokou dielektrickou konštantou (napr. v seignettových elektrikách, kde nadobúda hodnoty niekoľko tisíc, ba aj viac). Tam by nastali veľké odchýlky od rovnovážnej koncentrácie i pri koncentráciách $10^{14} - 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Efekt by sa zvyšoval ešte s teplotou.

V týchto naposledy uvádzaných prípadoch neobstojí teda bežne citované tvrdenie, že difúzia nosičov náboja, ktorá zanecháva po sebe nekompenzovaný náboj, prakticky nenastane.

3. Odchýlky od rovnovážnych koncentrácií pri nenulovom prúde

Ak je nehomogénna vzorka zafázená vonkajším napäťom, preteká ňou v rovnováhe ustálený prúd (1,2). Intenzita vonkajšieho poľa zapríčiní ďalší odklon od rovnovážnej koncentrácie, a keďže ide o nehomogénnu vzorku, možno očakávať, že odchýlky budú aj funkciou smeru priloženého poľa. Podľa toho by mala mať vzorka aj usmerňujúci účinok. Pokúsime sa v ďalšom vyšetriť, kedy by mohol tento efekt mať aj praktický význam.

Ak podobne ako v predchádzajúcej časti predpokladáme jednorozmerný prípad, môžeme intenzitu elektrostatického poľa vo vzorke na základe (1,2) vyjadriť takto:

$$E = \frac{i}{e n u} = \frac{k T}{e} \frac{d}{dx} \ln n. \quad (3,1)$$

Dosadíme sem $i = e u N_0 E_0$, kde E_0 je intenzita elektrostatického poľa vo vzorke v $x \rightarrow -\infty$ a pomocou (1,3) a (1,6) dostaneme pre y túto približnú diferenciálnu rovnici:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 2b \frac{dy}{dx} - c^2 N_0 e^{ax} y = E_0 a. \quad (3,2)$$

Pritom sme označili

$$2b = \frac{E_0 e}{k T}; \quad c = \sqrt{\frac{e^2}{e k T}}. \quad (3,3)$$

Riešenie rovnice (3,2) v I. a v III. oblasti s rešpektovaním prirodzených hraničných podmienok v nekonečnu je

$$y_1 = C_1 e^{(b + \lambda_0)x} + \frac{E_0 a}{c \sqrt{N_0}}, \quad (3,4)$$

$$y_{111} = C_6 e^{-(b + \lambda_l)x} - \frac{E_0 a}{c \sqrt{N_l}}, \quad (3,5)$$

kde

$$\lambda_0 = \sqrt{b^2 + c^2 N_0}, \quad (3,6)$$

$$\lambda_l = \sqrt{b^2 + c^2 N_l}. \quad (3,7)$$

V II. oblasti môžeme riešenie vyjadriť nasledovne:

$$y_{11} = e^{ax} \left[C_3 J_{\frac{2b}{a}} \left(\frac{2c}{a} \sqrt{N_0} e^{\frac{ax}{2}} \right) + C_4 K_{-\frac{2b}{a}} \left(\frac{2c}{a} \sqrt{N_0} e^{\frac{ax}{2}} \right) - \frac{E_0 a}{c^2 N_0} e^{-ax} \right] \quad (3,8)$$

I a K je Besselova, resp. MacDonaldova funkcia.

V konkrétnych prípadoch, napr. v germániu a v kremíku je približne $b = 18E_0$ a $c^2 N_0 = 4,3 \cdot 10^{-8} N_0$, z čoho vyplýva, že pri $N_0 \gg 10^9 E_0$ je vždy

$b \ll c^2 N_0$. Na základe toho môžeme položiť jednak $\lambda_0 = c^2 N_0$ a $\lambda_l = c^2 N_l$, jednak pre Besselove funkcie použiť aproximačné vzorce, platné pre veľké argumenty.

Ak si podobne ako v predchádzajúcom prípade označíme

$$\gamma_0 = 2 \sqrt{a\pi c} \sqrt{N_0} e^{-\frac{2c}{a} \sqrt{N_0}},$$

$$\beta_l = \frac{1}{2} e^{\left(b - \frac{a}{4}\right)} \left(1 + e^{\frac{al}{4}}\right) \sqrt{\frac{ac}{\pi} \sqrt{N_0} e^{-\frac{2c}{a} \sqrt{N_0} e^{al}}}. \quad (3,9)$$

dostaneme pre konštantu C_1 , t. j. pre pomer prírastku koncentrácie a pôvodnej rovnovážnej koncentrácie elektrónov v bode $x = 0$:

$$\frac{n - n_0}{n_0} = \frac{E_0 a}{\gamma_0 \beta_l} \left| \left(\frac{a}{c \sqrt{N_0}} \right)^3 \left\{ \beta_l \sqrt{\pi} e^{-\frac{2c}{a} \sqrt{N_0}} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{\pi}} \gamma_0 e^{al} \cdot e^{-\frac{2c}{a} \sqrt{N_0}} \right\} \right|. \quad (3,10)$$

Prvý člen zo zátvorky je väčší ako druhý, preto ak druhý člen zanedbáme, môžeme približne písat

$$\frac{n - n_0}{n_0} = \frac{E_0 a^2}{2} \left(\frac{e^2 N_0}{ekT} \right)^{-3/2}. \quad (3,11)$$

Pre germánium a kremík vychádza podľa toho pri izbovej teplote $(n - n_0)/n_0 = 5,5 \cdot 10^{10} a^2 N_0^{-3/2} E_0$. Aj pri takých malých koncentráciách, ako je $N_0 = 10^{12} \text{ cm}^{-3}$, je to len $5,5 \cdot 10^{-11} a^2 E_0$.

Z týchto nepatrnych odchýlok môžeme usudzovať, že aj usmerňovací efekt bude nepatrny. Aby sme ho mohli posúdiť, vypočítame celkovú zmenu odporu vzorky zapričinenú len zmenou polarity vonkajšieho poľa, pripadajúcu na interval $[0, l]$. Môžeme ju vyjadriť takto:

$$\Delta R = \Delta R_{+E_0} - \Delta R_{-E_0}, \quad (3,12)$$

kde

$$\Delta R_{\pm E_0} = \int_0^l \left(\frac{1}{\sigma_{\pm E_0}} - \frac{1}{\sigma_0} \right) dx \doteq - \int_0^l \frac{\Delta \sigma_{\pm E_0}}{\sigma_0^2} dx. \quad (3,13)$$

Na základe vzťahov (1,1) a (1,6) môžeme písat

$$\Delta \sigma = eu(n - n_0) = euN_0 e^{ax} y. \quad (3,14)$$

Jednoduchým výpočtom integrálu (3,13) dostaneme

$$\Delta R = \frac{E_0}{eu c^2 N_0^2} (1 - e^{-2al}). \quad (3,15)$$

Charakteristikou usmerňovacieho efektu môže byť podiel tejto zmeny a pôvodného odporu vzorky (bez prúdu), pre ktorý vychádza

$$\left| \frac{\Delta R}{R_0} \right| = \frac{E_0 a}{c^2 N_0} \cdot \frac{1 - e^{-2at}}{1 - e^{-at}}. \quad (3,16)$$

Pre germánium a kremík má tento podiel v ideálnom prípade hodnotu $2,5 \cdot 10^6 a E_0 / N_0$. Pre hustotu prúdu $i = 10 \text{ mA/cm}^2$, čo zodpovedá napr. koncentrácií $N_0 = 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ a intenzite pola $E_0 = 10 \text{ V/cm}$ by celková zmena odporu vzorky bola asi $(2,5 \cdot 10^{-5} \cdot a)$ časť pôvodného odporu.

Aby mohol v nehomogénnej vzorke vzniknúť merateľný usmerňovací efekt, musel by v ňom podľa (3,16) byť prudký skok v nehomogenite (veľké a) na malej dĺžke l .

Usmerňovací efekt však podľa vzťahu (3,16) vzrástá so zmenšovaním koncentrácie nosičov náboja, so vzrástom dielektrickej konštanty a teploty. Pri vhodnom pomere týchto konštánt by mohla mať aj nehomogénna vzorka polovodiča s pozvoľným gradientom prímesí merateľný usmerňovací efekt. Máme opäť na mysli látky s vysokou dielektrickou konštantou, v ktorých sú pre tieto efekty zvlášť priaznivé pomery, pretože prostredie s veľkou dielektrickou konštantou značne zoslabuje elektrostatické pole brzdiace difúziu

Záver

V práci sú odvodené vzorce pre ustálené hodnoty koncentrácie voľných elektrónov v polovodiči typu n za predpokladu, že možno v nich zanedbať koncentráciu dier, a to tak pre bezprúdový stav, ako aj pre prípad, keď vzorkou polovodiča preteká elektrický prúd. Ukázalo sa pritom, že v bežných prípadoch znečistenia v germániu a v kremíku vznikajú len veľmi nepatrné odchylinky od rovnovážnych koncentrácií voľných nosičov náboja, a to aj v prípade, keď na vzorku je pripojené vonkajšie elektrické pole. V iných polovodičoch, vyznačujúcich sa veľkou hodnotou dielektrickej konštanty, sú už tieto efekty značné a hlavne pri dostatočne malej koncentrácií voľných nosičov náboja nemožno ich zanedbať.

LITERATÚRA

- [1] Traue J.: Čs. čas. fys., 5 (1955), 34.
- [2] Pfann W. G.: Trans. AIMME, 194 (1953), 747—753.
- [3] Lord N. W.: J. Metals, 5, sec. 2 (1953), 11.
- [4] Burton J. A., Kolb E. D., Slichter W. P., Struthers J. D.: J. Chem. Phys., 21, 11 (1953), 1991—1996.
- [5] Hanbook of Semiconductor electronic, New York 1956.

- [6] Pekar S. J.: ŽETF, 10 (1940), 1210.
 [7] Тихонов А. Н., Самарский А. А.: Уравнения математической физики.
 Москва 1951.
 [8] Ноффе А. Ф.: Физика полупроводников, ИАН СССР, Москва - Ленинград 1957.

Došlo 4. októbra 1958.

Katedra fyziky Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave

**КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ЗАРЯДА В НЕОДНОРОДНОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ
С ОДИЫМ ТИПОМ ПРОВОДИМОСТИ**

ЮЛИЙС КРЕМПАСКИ

Выводы

В этой работе выведены формулы для стационарных концентраций в неоднородном примесном полупроводнике типа n с пренебрегаемой дырочной проводимостью как в состоянии когда полупроводником течет ток, так и в состоянии отсутствия тока. Показано, что непренебрегаемые отклонения от равновесной концентрации определяются концентрацией примеси и температурой, смогли бы возникать только в полупроводниках с большой неоднородностью и очень низкой концентрацией ионизированных атомов примесей, или в полупроводниках с высокой диэлектрической проницаемостью. Это самое, как показано, должно быть справедливо и для выпрямляющегося эффекта.

**CONCENTRATIONS OF FREE ELECTRONS
IN UNHOMOGENEOUS SEMICONDUCTOR
WITH N -TYPE CONDUCTIVITY**

JULIUS KREMPLASKÝ

Summary

The relations are found for equilibrium concentrations of electrons in inhomogeneously impured n -type semiconductor with vanishing hole conductivity in the current - less state as well as in the case when the current is present. It is shown that considerable deviations from equilibrium concentration which is determined by the temperature and concentration of impurities can arise only in semiconductors with the small concentration of ionized foreign atoms and with strong inhomogeneity eventually in semiconductor with high dielectric constant. The same is proved also about the rectification process in unhomogeneous semiconductor.